

石英晶体振荡器 (SMD)

4.3 XO2016

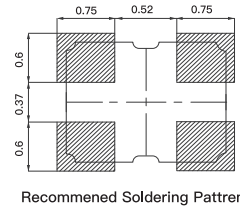
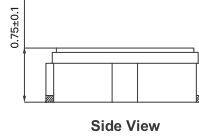
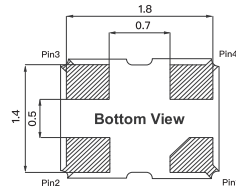
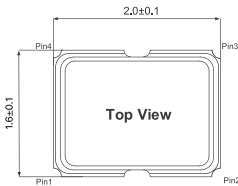
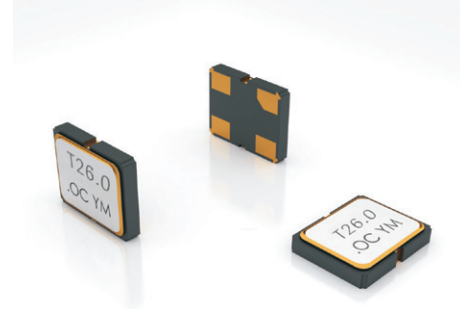
2.0×1.6 mm
CMOS晶体振荡器



产品特点及应用

- 外形尺寸 2.0 x 1.6 x 0.75mm
- 体积小、可靠性高
- 宽电源电压: 1.7-3.6V
- 可广泛应用于工业通讯、导航、雷达等领域
- AEC-Q100 & AEC-Q200适用

外形尺寸



Pin Connection

Name	Connection
pin 1	Tri - State
pin 2	GND
pin 3	Fout
pin 4	Vdd

电性能参数

技术指标		3.3V		2.5V		1.8V		Unit.
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
工作电压 (VDD)		VDD-5%	VDD+5%	VDD-5%	VDD+5%	VDD-5%	VDD+5%	V
输出频率		1	125	1	125	1	125	MHz
输入电流	在15pF负载时	—	25	—	25	—	20	mA
	无负载时, $1\text{MHz} \leq F_o < 10\text{MHz}$	—	1.0	—	1.0	—	0.75	mA
	无负载时, $10\text{MHz} \leq F_o < 20\text{MHz}$	—	1.0	—	1.0	—	0.75	mA
	无负载时, $20\text{MHz} \leq F_o < 80\text{MHz}$	—	1.3	—	1.3	—	1.0	mA
	无负载时, $80\text{MHz} \leq F_o < 125\text{MHz}$	—	6	—	6	—	3	mA
	占空比	45	55	45	55	45	55	%
输出电平	输出高电平	2.97	—	2.25	—	1.62	—	V
	输出低电平	—	0.33	—	0.25	—	0.18	
转换时间: 上升/下降时间+	$1.25\text{MHz} \leq F_o < 10\text{MHz}$	—	4	—	5	—	6	nSec
	$10\text{MHz} \leq F_o < 20\text{MHz}$	—	4	—	5	—	6	nSec
	$20\text{MHz} \leq F_o < 80\text{MHz}$	—	4	—	5	—	6	nSec
启动时间		—	5	—	5	—	5	mSec
三态 (接 Pin1)	启用 (高电平或者悬空)	0.7VDD	—	0.7VDD	—	0.7VDD	—	V
	禁用 (低电平或接地)	—	0.3VDD	—	0.3VDD	—	0.3VDD	
输出负载		15		15		15		pF
待机电流		—	100	—	100	—	100	uA
老化率 (@25°C, 第一年)		—	±3	—	±3	—	±3	ppm
存储温度		-55	125	-55	125	-55	125	°C
抖动 (峰峰值)		—	40	—	40	—	40	pSec
相位抖动均方根 (12KHz ~ 20MHz)		—	1	—	1	—	1	pSec

标准频率是指晶体设计的频率,并不表示存货状况。

+ 转换时间是在电源电压10% ~ 90%变化范围内测量的。

石英晶体振荡器(SMD)

频率稳定度 vs. 温度范围

温度(°C)	ppm	±20	±25	±50
-10 ~ +60		○	○	○
-20 ~ +70		○	○	○
-40 ~ +85		△	○	○
-40 ~ +125		×	×	○

*○: 可提供 △: 有条件下提供 ×: 不可提供

* 包括 25 °C, 工作温度范围, 输入电压变化, 负载变化, 老化率 (第一年), 冲击和振动条件下校准。

注意: 并非所有选项组合都可提供。其他规格可根据要求提供。规格如有更改, 恕不另行通知。